



# 产品规格书

1064nm 高功率半导体激光二极管芯片



# 1064nm 高功率半导体激光二极管芯片

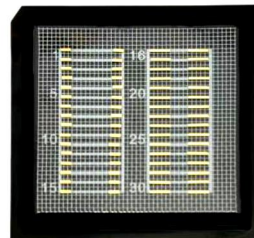
(LC-UMC-95-1064-TE-8-4.0-D1)

## 性能特点

- GaAs 量子阱
- 高功率
- 高效率
- 高可靠性

## 典型应用

- 中高功率工业光纤激光器泵浦
- 生物医学
- 激光装备
- 科研



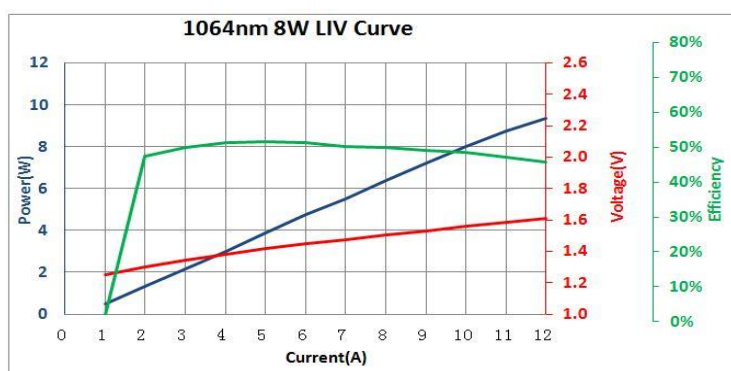
## 光电性能 (@Tc=25±3°C)

型号: (LC-UMC-95-1064-TE-8-4.0-D1)					
Item	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
<b>Operation</b>					
Central Wavelength 中心波长 (CW)	$\lambda$		1064		[nm]
Optical output power 输出功率	$P_{opt}$		8		[W]
Operation mode 工作模式			CW		
Power modulation 功率调制率			100		[%]
<b>Geometrical</b>					
Emitter Width 出光窗口宽度	W		95		[ $\mu$ m]
Emitter Pitch 发光点周期	P	390	400	410	[ $\mu$ m]
Cavity Length 腔长	L	3990	4000	4010	[ $\mu$ m]
Thickness 厚度	D	110	130	150	[ $\mu$ m]
<b>Electro Optical Data</b>					
Fast Axis Divergency (FWHM) 快轴发散角	$\theta_{\perp}$		29		deg
Slow Axis Divergency (FWHM) 慢轴发散角	$\theta_{\parallel}$		9		deg
Spectral Bandwidth (FWHM) 光谱宽度	$\Delta\lambda$		4		[nm]
Pulse Wavelength 脉冲波长	$\lambda$	1055	1058	1061	[nm]
Slope Efficiency 斜率效率	$\eta$	0.8	0.9		[W/A]
Conversion efficiency 转换效率		51	55		[%]
Threshold Current 阈值电流	$I_{th}$		0.4	0.5	[A]
Operating Current 工作电流	$I_{op}$		10	11	[A]
Operating Voltage 工作电压	$V_{op}$		1.65	1.75	[V]
Temperature Characteristics (d $\lambda$ /dT) 温度特性			0.35		[nm/°C]
Polarization 偏振			TE		
LD Operating Temperature 工作温度		15	25	35	[°C]

## 极限参数

参数名称	符号	额定值	单位
工作温度	Tc	-20 ~ +60	°C
存储温度	Tstg	-40 ~ +125	°C
最大输出功率	Pmax	15	W
最大正向电流	If	16	A

## 测试曲线



LIV 曲线

说明:

- 1、单位：微米
- 2、发光区宽度：180微米
- 3、P电极：芯片正面，电极厚度0.3微米±0.03微米
- 4、N电极：芯片背面，电极厚度 0.6 微米±0.03 微米

### 注意事项

应采取必要的 ESD 防护措施，已避免芯片被静电损伤。

GaAs 基芯片易碎，取用时需十分小心。推荐使用真空吸附方式取用芯片。

焊接力度、温度等参数需小心设置，已避免损坏芯片。

